

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年9月30日(2021.9.30)

【公開番号】特開2020-191480(P2020-191480A)

【公開日】令和2年11月26日(2020.11.26)

【年通号数】公開・登録公報2020-048

【出願番号】特願2020-143091(P2020-143091)

【国際特許分類】

H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/8234	(2006.01)
H 01 L	27/06	(2006.01)
H 01 L	27/088	(2006.01)
H 01 L	21/28	(2006.01)
H 01 L	29/417	(2006.01)

【F I】

H 01 L	29/78	6 1 6 U
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	29/78	6 1 6 V
H 01 L	27/06	1 0 2 A
H 01 L	27/088	C
H 01 L	27/088	3 3 1 E
H 01 L	21/28	3 0 1 B
H 01 L	29/50	M

【手続補正書】

【提出日】令和3年8月23日(2021.8.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

同一基板上に画素部と駆動回路部とを有し、

前記画素部は、第1の酸化物半導体層にチャネル形成領域を有する第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタと電気的に接続される発光素子と、を有し、

前記駆動回路部は、第2の酸化物半導体層にチャネル形成領域を有する第2のトランジスタを有し、

前記第1のトランジスタは、前記第1の酸化物半導体層の一方側のみに、前記第1の酸化物半導体層と重なる第1のゲート電極層を有し、

前記第2のトランジスタは、前記第2の酸化物半導体層の上下両側に、前記第2の酸化物半導体層と重なる第2のゲート電極層及び第3のゲート電極層を有し、

前記第1のトランジスタは、前記第1の酸化物半導体層の下方に設けられた第1のソース電極層及びドレイン電極層を有し、

前記第2のトランジスタは、前記第2の酸化物半導体層の下方に設けられた第2のソース電極層及びドレイン電極層を有し、

前記発光素子は、第1の電極と、前記第1の電極上のEL層と、前記EL層上の第2の電極と、を有する表示装置。